

## 大見研究室 和文 論文リスト

## 1996 年

- 676(M) 大見忠弘、久保和樹、「新概念に基づいたシリコン表面洗浄」、カিজョウ技報、Vol.2、No.3、(株カイジョー)、pp.7-18、1996年1月。
- 677(M) 岩本敏幸、三宅利紀、大見忠弘、「極薄酸化膜の形成」、H7.11.13~14 物性研短期研究会報告、物性研だより、第35巻、第5号、(物性研)、pp.41-46、1996年1月。
- 678(B) 大見忠弘、「序文 ガスサイエンスが拓くプロダクトイノベーション」、ガスサイエンスが拓くプロダクトイノベーション、(株リアライズ社)、1996年1月。
- 679(B) 大見忠弘、「序章:1.半導体製造技術の課題、2.半導体製造技術における緊急開発課題、3.超高純度ガス供給系」、ガスサイエンスが拓くプロダクトイノベーション、(株リアライズ社)、pp.1-36、1996年1月。
- 680(B) 大見忠弘、「第4章 ウltraクリーンガス技術が切り拓く高性能プロセス 1.アルミニウムおよびSiスパッタ成膜の高品質化」、ガスサイエンスが拓くプロダクトイノベーション、(株リアライズ社)、pp.327-352、1996年1月。
- 681(P) 小川勝久、柴田直、大見忠弘、高津求、横山直樹、「ニューロンMOSを用いた多入力・オフセットフリー演算増幅器」、東京工業大学学内共同研究シンポジウム 生体的情報処理デバイスとシステム応用、(東京工業大学)、pp.23-29、1996年1月。
- 682(M) 大見忠弘、「一巻頭言—Scientific Semiconductor Manufacturing 実現へ」、ウルトラクリーンテクノロジー、Vol.8、No.1、(半導体基盤技術研究会)、pp.2-4、1996年2月。
- 683(B) 小谷光司、柴田直、大見忠弘、「第3章 イオン注入工程におけるチャージング・ダメージ 2.イオン注入によるMOSデバイスのチャージング・ダメージ」、半導体プロセスにおけるチャージング・ダメージ、(株リアライズ社)、pp.181-186、1996年2月。
- 684(M) 大見忠弘、「〈ミニ特集 シリコンの極限清浄表面を計測する〉サブクォータマイクロン時代の半導体生産技術」、計測と制御、Vol.35、No.3、((社)計測自動制御学会)、pp.171-178、1996年3月。
- 685(M) 米川直道、小島泉里、大見忠弘、「〈ミニ特集 シリコンの極限清浄表面を計測する〉極微量の有機物汚染を計測する」、計測と制御、Vol.35、No.3、((社)計測自動制御学会)、pp.185-190、1996年3月。
- 686(M) 泉浩人、白井泰雪、大見忠弘、「〈ミニ特集 シリコンの極限清浄表面を計測する〉表面吸着水分の計測」、計測と制御、Vol.35、No.3、((社)計測自動制御学会)、pp.191-195、1996年3月。
- 687(M) 森田瑞穂、大見忠弘、「極限集積化デバイスのしきい値支配因子自己収束プロセスの研究—ゲート酸化膜厚測定法の高精度化の研究—」、平成7年度重点領域研究 極限集積化シリコン知能エレクトロニクス(269)、pp.180-183、1996年3月。
- 688(M) 柴田直、中井務、余寧梅、菅田正宏、山下雄一郎、大見忠弘、「“連想するハードウェア”をベースとした知的電子システムの研究」、平成7年度重点領域研究 極限集積化シリコン知能エレクトロニクス(269)、pp.324-341、1996年3月。
- 689(M) 大見忠弘、小谷光司、今井誠、柴田直、「Flexware—しなやかで瞬時応答可能な知能集積システム—」、平成7年度重点領域研究 極限集積化シリコン知能エレクトロニクス(269)、pp.376-390、1996年3月。
- 690(M) 大見忠弘、「TPMと半導体産業」、TPMと半導体工場、((社)日本プラントメンテナンス協会)、pp.16-28、1996年3月。
- 691-1(P) 大見忠弘、「アドバンスドクォータマイクロン時代以降のシリコン結晶」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 27、プロシーディング[別冊]、(半導体基盤技術研究会)、pp.I-i~I-iv、1996年3月。

- 692(P) 久次米孝信、久保和樹、森田博志、大見忠弘、「オゾン・メガソニックを利用した最新ウェット洗浄技術」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 27、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.65-74、1996年3月。
- 693(M) 平野有一、島田久幸、牛木健雄、大見忠弘、「タンタルゲート電極を用いたSOI MOSFETの閾値制御」、電子情報通信学会技術報告、Vol.95、No.570、シリコン材料デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号SDM95-267、pp.31-38、1996年3月。
- 694(P) 白井泰雪、大見忠弘、「ステンレス配管システムの酸化クロム不働態処理」、ウルトラクリーンテクノロジー、Vol.8、No.2、(半導体基盤技術研究会)、pp.98-101、1996年4月。
- 695(P) 池田信一、篠原努、山路道雄、大見忠弘、「インスペクションフリーを実現する高性能継手」、ウルトラクリーンテクノロジー、Vol.8、No.2、(半導体基盤技術研究会)、pp.102-106、1996年4月。
- 696(M) 大見忠弘、「膜質向上にエピ導入は必然、課題のメタル混入をチャンバ表面処理で対策」、日経マイクロデバイス、Vol.6、No.132、(日経BP社)、pp.129-133、1996年6月。
- 697(M) 小嶋努、白井泰雪、中村修、大見忠弘、「(超高純度ガスパネルのクリーンテクノロジー)高性能クリーン溶接技術」、クリーンテクノロジー、Vol.6、No.6、(日本工業出版)、pp.10-15、1996年6月。
- 698(M) 都田昌之、加藤正行、久保和樹、小島泉里、大見忠弘、「(メガソニック洗浄)メガソニック励起超純水による表面清浄化」、クリーンテクノロジー、Vol.6、No.6、(日本工業出版)、pp.44-50、1996年6月。
- 699(P) 大見忠弘、「一巻頭言ー新しい表面洗浄と計測技術を求めて」、ウルトラクリーンテクノロジー、Vol.8、No.3、(半導体基盤技術研究会)、pp.140-143、1996年6月。
- 700(P) 森永均、大見忠弘、「半導体ウェットプロセスにおける金属汚染の吸着・脱離メカニズム」、ウルトラクリーンテクノロジー、Vol.8、No.3、(半導体基盤技術研究会)、pp.144-155、1996年6月。
- 701(P) 板野充司、毛塚健彦、久保元伸、大見忠弘、「ウェット洗浄での粒子の脱着」ウルトラクリーンテクノロジー、Vol.8、No.3、(半導体基盤技術研究会)、pp.156-160、1996年6月。
- 702(P) 泉浩人、宮下雅之、山根香代、菊山裕久、大見忠弘、「ウェットプロセス制御のための薬液組成管理方法」、ウルトラクリーンテクノロジー、Vol.8、No.3、(半導体基盤技術研究会)、pp.161-164、1996年6月。
- 703(F) 都田昌之、加藤正行、久保和樹、小島泉里、大見忠弘、「メガソニック励起超純水による表面清浄化」、ウルトラクリーンテクノロジー、Vol.8、No.3、(半導体基盤技術研究会)、pp.183-195、1996年6月。
- 704(F) 大見忠弘、「フッ化不働態処理ガス供給技術」、第14回大阪酸素ー半導体セミナー講演集、(大阪酸素工業株)、pp.59-75、1996年6月。
- 705(F) 大見忠弘、「一序論ーシリコンの科学」、シリコンの科学、半導体基盤技術研究会編、大見忠弘、新田雄久監修、(株)リアライズ社)、pp.3-13、1996年6月。
- 706(B) 久保和樹、小島泉里、大見忠弘、「第4節ウェーハの洗浄 第2項次世代デバイス対応の洗浄技術(C)オゾン添加超純水による洗浄技術」、シリコンの科学、半導体基盤技術研究会編、大見忠弘、新田雄久監修、(株)リアライズ社)、pp.369-376、1996年6月。
- 707(P) 白井泰雪、橋本泰司、榎崎勝貴、大見忠弘、中川佳紀、「エキシマレーザー用ガス配管システム」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 28、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.66-75、1996年7月。
- 708(P) 大見忠弘、「ウェーハフローパスミニマムを実現する最新洗浄技術」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 28、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.79-96、1996年7月。
- 709(P) 久次米孝信、川田和彦、西山泰司、菊山裕久、大見忠弘、「次世代室温ウェット洗浄技術(1)」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 28、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.97-104、1996年7月。

- 710(P) 川田和彦、岡野勝一、久次米孝信、森田博志、新田雄久、大見忠弘、「次世代室温ウェット洗浄技術(2)」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 28、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.105-112、1996年7月。
- 711(P) 小島泉里、自在丸隆行、尾前俊吉、大見忠弘、「室温レジスト剥離技術」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 28、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.113-120、1996年7月。
- 712-1(P) 大見忠弘、「次世代エキシマレーザステップが拓くリソグラフィ技術」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 28、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.139-151、1996年7月。
- 713(P) 都田昌之、加藤正行、大見忠弘、「メガソニック励起超純水の科学」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 28、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.152-175、1996年7月。
- 714(M) 大見忠弘、「特殊鋼に期待する」、特殊鋼、Vol.45、No.7、(大同特殊鋼株)、pp.7-9、1996年7月。
- 715(P) 大見忠弘、「最新半導体製造プロセス技術と高歩留まり化への課題」、第226回講習会半導体デバイス高歩どまり化のための先端技術に関する講習会テキスト、((社)精密工学会)、pp.1-12、1996年7月。
- 716(P) 大見忠弘、柴田直、「シリコン表面プロセスにおける現実的なラフネス揺らぎのない半導体プロセスで人工知能システム実現を目指す」、第24回薄膜・表面物理セミナー、((社)応用物理学会)、pp.7-16、1996年7月。
- 717(P) 大見忠弘、「集積回路設計の教育」、平成8年度大学電気工学教育研究集会分科会予稿集、(金沢大学)、pp.1-2、1996年7月。
- 718(P) 中井努、柴田直、大見忠弘、「擬似2次元画像処理を用いたニューロンMOS動きベクトル検出回路」、1996年テレビジョン学会年次大会、((社)テレビジョン学会)、pp.27-28、1996年7月。
- 719(P) 余寧梅、柴田直、大見忠弘、「ニューロンMOS重心検出回路」、1996年テレビジョン学会年次大会、((社)テレビジョン学会)、pp.29-30、1996年7月。
- 720(F) 柴田直、大見忠弘、「半導体プロセスにおける真空の役割」、ウルトラクリーンテクノロジー、Vol.8、No.4、(半導体基盤技術研究会)、pp.251-255、1996年8月。
- 721(P) 黄景宏、柴田直、大見忠弘、「CMOSソースフォロワのアンチミラー効果を用いた無相関ノイズ発生器」、平成8年度電気関係学会東北支部連合大会講演論文集、(電気関係学会東北支部)、p.312、1996年8月。
- 722(P) 山下雄一郎、柴田直、大見忠弘、「実時間認識システムのためのアナログEEPROM技術」、平成8年度電気関係学会東北支部連合大会講演論文集、(電気関係学会東北支部)、p.325、1996年8月。
- 723(P) 中井努、柴田直、大見忠弘、「ニューロンMOS動きベクトル検出回路」、平成8年度電気関係学会東北支部連合大会講演論文集、(電気関係学会東北支部)、p.326、1996年8月。
- 724(P) 余寧梅、柴田直、大見忠弘、「ニューロンMOSを用いた実時間重心検出回路」、平成8年度電気関係学会東北支部連合大会講演論文集、(電気関係学会東北支部)、p.327、1996年8月。
- 725(P) 篠原壽邦、牛木健雄、大見忠弘、「MOSFETゲート絶縁膜用Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>薄膜形成」、平成8年度電気関係学会東北支部連合大会講演論文集、(電気関係学会東北支部)、p.335、1996年8月。
- 726(P) 金本啓、中田明良、岡マウリシオ正純、玉井幸夫、大見忠弘、「BF<sub>2</sub>+イオン注入層の低温アニールによる低リーク極浅接合の形成」、平成8年度電気関係学会東北支部連合大会講演論文集、(電気関係学会東北支部)、p.336、1996年8月。
- 727(P) 海原竜、竹脇利至、大見忠弘、新田雄久、「高エレクトロマイグレーション耐性銅合金配線技術」、平成8年度電気関係学会東北支部連合大会講演論文集、(電気関係学会東北支部)、p.339、1996年8月。

- 728(P) 山内経則、中村俊二、米澤岳美、余寧梅、柴田直、瀬戸山孝男、大見忠弘、「多結晶シリコン抵抗の安定化技術」、電子情報通信学会技術報告、Vol.96、No.228、集積回路、((社)電子情報通信学会)、論文番号 ICD96-97~109、pp.37-44、1996年8月。電子情報通信学会技術報告、Vol.96、No.226、シリコン材料・デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM96-77~89、pp.37-44、1996年8月。
- 729(M) 大見忠弘、森田博志、西山泰史、「RCA洗浄に変わる新しい洗浄技術」、クリーンテクノロジー、Vol.6、No.9、(日本工業出版)、pp.29-34、1996年9月。
- 730(P) 柴田直、大見忠弘、「ニューロンMOSトランジスタで実現する“しなやかな”情報処理ハードウェア—連想するハードウェアをベースに知的電子システムを構築する—」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.96、No.303、集積回路、((社)電子情報通信学会)、論文番号 ICD96-146、pp.47-56、1996年10月。
- 731(M) 大見忠弘、白井泰雪、「次世代半導体生産工場におけるガス技術」、セミコンダクターアニュアル/ガス供給編1996年版、臨時増刊、((有)ガスメディア社)、pp.14-20、1996年10月。
- 732(P) 榑崎勝貴、橋本泰司、白井泰雪、大見忠弘、「エキシマレーザステップ用ガス供給システム」、第8回超高純度ガス供給系技術懇談会技術資料、(株フジキン)pp.1-7、1996年11月。
- 733(P) 篠原努、山路道雄、池田信一、大見忠弘、「高性能継手を用いた集積化ガスシステムの効果」、第8回超高純度ガス供給系技術懇談会技術資料、(株フジキン)、pp.25-37、1996年11月。
- 734(P) 中村修、白井泰雪、五十木幹彦、大見忠弘、「工場建設における配管施工のCPU管理と溶接技術」、第8回超高純度ガス供給系技術懇談会技術資料、(株フジキン)、pp.39-47、1996年11月。
- 735(P) 大見忠弘、「0.25 $\mu$ m $\times$ 300mm ウェハ製造におけるガス供給・排気技術」、第8回超高純度ガス供給系技術懇談会技術資料、(株フジキン)、pp.49-62、1996年11月。
- 736(P) 大見忠弘、「21世紀へ向けたULSI生産技術の課題」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.96、No.359、シリコン材料デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM96-124、pp.43-53、1996年11月。
- 737(P) 外塚聖亭、加藤正行、都田昌之、大見忠弘、「RCA洗浄溶液に生成する活性種の評価」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.96、No.359、シリコン材料デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM96-127、pp.71-78、1996年11月。
- 738(P) 加藤正行、落合武臣、都田昌之、大見忠弘、「ウェハ洗浄溶液のラジカル活性に対する超音波照射の影響」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.96、No.359、シリコン材料デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM96-128、pp.79-86、1996年11月。
- 739(P) 権浩燁、柴田直、大見忠弘、「低消費電力ニューロンMOS論理ゲート」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.96、No.360、シリコン材料デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM96-136、pp.31-38、1996年11月。
- 740(P) 玉井幸夫、中田明良、岡マウシオ正純、柴田直、大見忠弘、「基板不純物濃度低減による450 $^{\circ}$ Cアニールイオン注入接合の特性改善」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.96、No.360、シリコン材料デバイス、((社)電子情報通信学会)、論文番号 SDM96-141、pp.63-68、1996年11月。
- 741(P) 白井泰雪、中村修、榑崎勝貴、大見忠弘、「ステンレス表面の酸化クロム不働態処理」、電気学会研究会資料 金属・セラミックス研究会、((社)電気学会)、pp.61-68、1996年11月。
- 742(P) 泉浩人、中川佳紀、矢崎洋史、菊山裕久、大見忠弘、「フッ素ガスを用いた金属表面処理」、電気学会研究会資料 金属・セラミックス研究会、((社)電気学会)、pp.69-74、1996年11月。
- 743(P) 大見忠弘、「高温プロセスチャンバー・高温真空排気系—異物付着 異物発生を抑制するプロセス装置—」、先端真空技術シンポジウム(山中湖シンポジウム)、((財)真空科学研究所)、1996年11月。
- 744(W) 尾前 俊吉、自在丸 隆行、小島 泉里、大見 忠弘、「室温レジスト除去技術」、第7回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.5-10、1996年11月。

- 745(W) 牛木 健雄、余 謨群、平野 有一、島田 久幸、森田 瑞穂、大見 忠弘、「ウルトラクリーン低温プロセスを用いた高信頼性タンタルゲート完全空乏化 SOI MOSFET」、第7回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.55-61、1996年11月。
- 746(W) 山内 経則、中村 俊二、米沢 岳美、余 寧梅、柴田 直、瀬戸山 孝男、大見 忠弘、「多結晶シリコンの安定化技術」、第7回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.65-72、1996年11月。
- 747(W) 大見 忠弘、「最新半導体プロセス技術と高歩留まり化への課題」、第7回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.85-96、1996年11月。
- 748-1(P) 大見忠弘、「半導体製造の今後の方向性」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 29、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.3-14、1996年12月。
- 749(P) 西山泰史、岡野勝一、白井泰雪、大見忠弘、「最新CMP技術」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNO. 29、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.41-48、1996年12月。
- 750(P) 川田和彦、岡野勝一、久次米孝信、森田博志、新田雄久、大見忠弘、「高速室温ウェットクリーニングのための新型スピン洗浄機」、超LSIウルトラクリーンテクノロジーシンポジウムNo. 29、プロシーディング、(半導体基盤技術研究会)、pp.76-84、1996年12月。